

## **Bekanntmachung des Landratsamtes Aschaffenburg vom 23.07.2020**

### **Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); Antrag auf Errichtung und Betrieb nach § 4 i. V. m. § 10 BImSchG einer Plasma- und MCVD-Anlage zur Herstellung von dotiertem Quarzglas am Standort Reinhard-Heraeus-Ring 29 in 63801 Kleinostheim, Fl.Nr. 8619, in der Gemarkung Kleinostheim**

Das Landratsamt Aschaffenburg hat der Firma Heraeus Quarzglas GmbH & Co.KG, Quarzglas 8, 63450 Hanau mit Bescheid vom 10.07.2020 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb nach § 4 i. V. m. § 10 BImSchG einer Plasma- und MCVD-Anlage zur Herstellung von dotiertem Quarzglas am Standort Reinhard-Heraeus-Ring 29 in 63801 Kleinostheim, in der Gemarkung Kleinostheim erteilt.

Das Landratsamt Aschaffenburg macht den verfügenden Teil der Entscheidung vom 10.07.2020 sowie die Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG öffentlich bekannt:

#### **I. Entscheidung:**

##### **1. Genehmigung nach § 4 BImSchG**

Der Fa. Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstr. 8, 63450 Hanau wird die Genehmigung nach § 4 BImSchG für folgende Maßnahmen auf dem Betriebsgelände Reinhard-Heraeus-Ring 29 in 63801 Kleinostheim, Fl.Nr. 8619, in der Gemarkung Kleinostheim erteilt:

- Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung im industriellen Umfang zur Herstellung von sonstigen anorganischen Verbindungen (Nr. 4.1.16 des Anhang 1 der 4. BImSchV – Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie)
- Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von in der Stoffliste zu Nummer 9.3 (Anhang 2 der 4. BImSchV) genannten Stoffen dient, mit einer Lagerkapazität von den in Spalte 3 der Stoffliste (Anhang 2) bis weniger als den in Spalte 4 der Anlage ausgewiesenen Mengen (Nr. 9.3.2 des Anhang 1 der 4. BImSchV i. V. m. Anhang 2 Nr. 30)

## 2. Anlagenumfang/Kenndaten der Anlage

2.1 Die Gesamtanlage unterteilt sich in folgende Betriebseinheiten (BE)/Nebeneinrichtungen:

- BE 1 Plasma-Anlagen
- BE 2 MCVD-Anlage
- BE 3 vertikale Drehbänke
- BE 4 Dreh- und Ansetzbänke
- BE 5 Faserziehtürme
- BE 6 Werkstätten
- BE 7 Abgasbehandlung
- BE 8 Siliciumtetrachlorid- und Schwefelhexafluorid-Versorgung<sup>1</sup>
- BE 9 Gefahrstoff- und Betriebsmittellagerung
- BE 10 Infrastruktur

2.2 Kenndaten der Anlage:

Gesamtproduktionsleistung

- Sechs Plasma-Anlagen zur Außenbeschichtung von Quarzglasträgern mit einer Gesamtkapazität von 25 t dotierten Quarzglasprodukten pro Jahr [ausgehend von insgesamt 4 t/a synthetischen und dotierten Quarzglas zur Abscheidung in der Anlage (sechs Plasma-Anlagen und eine MCVD-Anlage)]
- Eine MCVD-Anlage zur Innenbeschichtung von Quarzglasträgern mit einer Gesamtkapazität von 0,5 t dotieren Quarzglasprodukten pro Jahr [ausgehend von insgesamt 4 t/a synthetischen und dotierten Quarzglas zur Abscheidung in der Anlage (sechs Plasma-Anlagen und eine MCVD-Anlage)]

Die Betriebszeiten (inklusive Reinigungsarbeiten) sind:  
Montag bis Sonntag von **00.00 Uhr bis 24.00 Uhr**

## 3. Eingeschlossene Entscheidung

Diese Genehmigung schließt die Tektur zu der am 11.04.2019 unter dem Az. 91.3-6024-2018-1393-BAG erteilten Baugenehmigung nach Art. 68 der Bayer. Bauordnung (BayBO) für die Errichtung eines Produktionsgebäudes mit Kopfbau ein.

3.1 Folgende **Befreiungen** werden zugelassen:

Das Baugrundstück liegt im Baugebiet "Industriegebiet Heraeusring", für das ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt. Die vorgesehene Bebauung weicht von den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes in Folgendem ab:

- Überschreitung der festgesetzten maximalen Traufhöhe von 20,00 m durch den Schornstein der Abluftbehandlungsanlage (Emissionsquelle 8)

---

<sup>1</sup> Nebeneinrichtung selbstständig genehmigungsbedürftige Anlage nach Nr. 9.3.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV

um 6,00 m und durch den Schornstein der Glastechnik (Emissionsquelle 9) um 11,00 m.

### 3.2 **Bedingung**

3.2.1 Eine Nutzungsaufnahme darf erst erfolgen, wenn die entsprechende Bestätigung über die Verwirklichung des bescheinigten Brandschutzkonzeptes (Brandschutz II) des Prüfsachverständigen, der Bauaufsicht des Landratsamtes Aschaffenburg vorliegt (vgl. Art. 77 Abs. 2 Satz 3 BayBO).

3.2.2 Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebes die ordnungsgemäße Behandlung der anfallenden Prozessabwässer gem. parallel erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen nach §§ 58 und 60 WHG gesichert ist.

4. Für die Anlage ist maßgeblich das BVT-Merkblatt:  
„Herstellung anorganischer Spezialchemikalien“; Stand: 26.03.2015

### 5. **Kosten:**

Die Fa. Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG hat als Antragstellerin die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Die Gebühren werden auf 59.240,00 € festgesetzt. Auslagen sind in Höhe von 29.237,10 € angefallen. An Zustellungsgebühren fallen 10,40 € an. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 88.487,50 €.

## II. **Antragsunterlagen**

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

„ ... “

Der Genehmigungsbescheid wurde unter den dort aufgeführten Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz, Abfallrecht, zum Gewässerschutz, zum Baurecht sowie zum Arbeitsschutz erteilt und ist mit nachfolgender Rechtsbehelfsbelehrung versehen:

## **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats** nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

**Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg in 97082 Würzburg**  
**Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg,**  
**Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg,**

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.

Die Genehmigungsbehörde hat im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach ordnungsgemäßer Beteiligung der Öffentlichkeit unter Berücksichtigung aller Stellungnahmen der Fachbehörden geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen vorliegen. Sie ist zu dem Ergebnis gelangt, dass sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und aus Rechtsverordnungen aufgrund von § 7 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen nicht entgegenstehen. Die Genehmigung war daher zu erteilen.

### **Auslegung der Entscheidung:**

Eine Ausfertigung des vollständigen Genehmigungsbescheides einschließlich der Begründung liegt

**vom 24.07.2020 bis einschließlich 06.08.2020 (Auslegungsfrist)**

im Landratsamtes Aschaffenburg, Bayernstraße 18, 63739 Aschaffenburg, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.

Mit Datum vom 11.03.2020 hat die WHO den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus zur Pandemie erklärt. Das Robert-Koch-Institut, die Bundes- und Landesbehörden sowie die regionalen Gesundheitsämter haben entsprechende Verhaltensregeln zum Umgang mit dem Corona-Virus vorgegeben. Um die Infektionskette nachhaltig zu durchbrechen, sollen soziale Kontakte und Interaktionen möglichst vermieden oder auf ein Minimum beschränkt werden.

Daher kann der Zugang zum Landratsamt Aschaffenburg derzeit nur nach Terminvereinbarung ermöglicht werden.

Zur Terminvereinbarung stehen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Telefon: 06021/394-505  
Fax: 06021/394-905  
E-Mail: [immissionsschutz@lra-ab.bayern.de](mailto:immissionsschutz@lra-ab.bayern.de)

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite des Landratsamtes Aschaffenburg (<https://www.landkreis-aschaffenburg.de>) unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Darüber hinaus werden entsprechend § 10 Abs. 8 a BImSchG der Genehmigungsbescheid mit Ausnahme in Bezug genommener Antragsunterlagen und des Ausgangszustandsberichts sowie die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblattes unter der Unterrubrik „Genehmigungsbescheide“ veröffentlicht.

Landratsamt Aschaffenburg  
Aschaffenburg, 23. Juli 2020

Katrin Brand  
Oberregierungsrätin